

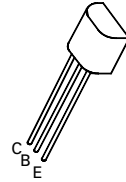
# NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 2 – MARCH 1994

## FEATURES

- \* 300 Volt  $V_{CEO}$
- \* 0.5 Amp continuous current
- \*  $P_{tot} = 1$  Watt

# ZTX457



**E-Line**  
**TO92 Compatible**

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER                                  | SYMBOL         | VALUE       | UNIT        |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Collector-Base Voltage                     | $V_{CBO}$      | 300         | V           |
| Collector-Emitter Voltage                  | $V_{CEO}$      | 300         | V           |
| Emitter-Base Voltage                       | $V_{EBO}$      | 5           | V           |
| Peak Pulse Current                         | $I_{CM}$       | 1           | A           |
| Continuous Collector Current               | $I_C$          | 500         | mA          |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | $P_{tot}$      | 1           | W           |
| Operating and Storage Temperature Range    | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +200 | $^{\circ}C$ |

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

| PARAMETER                             | SYMBOL         | MIN.           | TYP. | MAX.      | UNIT          | CONDITIONS.                                                                       |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Collector-Base Breakdown Voltage      | $V_{(BR)CBO}$  | 300            |      |           | V             | $I_C=100\mu A, I_E=0$                                                             |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage   | $V_{CEO(sus)}$ | 300            |      |           | V             | $I_C=10mA, I_B=0^*$                                                               |
| Emitter-Base Breakdown Voltage        | $V_{(BR)EBO}$  | 5              |      |           | V             | $I_E=100\mu A$                                                                    |
| Collector Cut-Off Current             | $I_{CBO}$      |                |      | 100<br>10 | nA<br>$\mu A$ | $V_{CB}=200V$<br>$V_{CB}=200V, T_{amb}=100^{\circ}C$                              |
| Emitter Cut-Off Current               | $I_{EBO}$      |                |      | 100       | nA            | $V_{EB}=4V$                                                                       |
| Collector-Emitter Saturation Voltage  | $V_{CE(sat)}$  |                |      | 0.3       | V             | $I_C=100mA, I_B=10mA^*$                                                           |
| Base-Emitter Saturation Voltage       | $V_{BE(sat)}$  |                |      | 1         | V             | $I_C=100mA, I_B=10mA^*$                                                           |
| Base-Emitter Turn On Voltage          | $V_{BE(on)}$   |                |      | 1         | V             | $I_C=100mA, V_{CE}=10V^*$                                                         |
| Static Forward Current Transfer Ratio | $h_{FE}$       | 50<br>50<br>25 |      | 300       |               | $I_C=10mA, V_{CE}=10V^*$<br>$I_C=50mA, V_{CE}=10V^*$<br>$I_C=100mA, V_{CE}=10V^*$ |
| Transition Frequency                  | $f_T$          | 75             |      |           | MHz           | $I_C=50mA, V_{CE}=10V$<br>$f=20MHz$                                               |

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9